








	<h2 style="color: red;">APT68GA60B2D40</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">APT68GA60B2D40</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Microsemi</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IGBT 600V 121A 520W TO-247
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">APT68GA60B2D40.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2615 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Artikelnummer	<a href="#">APT68GA60B2D40</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	IGBT 600V 121A 520W TO-247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-IGBTs-Einzel</a>
Teilstatus	2615 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.5V @ 15V, 40A
Testbedingung	400V, 40A, 4.7 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	21ns/133ns
Schaltenergie	715µJ (on), 607µJ (off)
Serie	POWER MOS 8™
Leistung - max	520W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3 Variant
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	PT
Gate-Ladung	198nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	202A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	121A

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>APT70GR120B2</b> Microsemi Corporation IGBT 1200V 160A 961W TO247</p>	 <p><b>APT66F60L</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 70A TO-264</p>	 <p><b>APT68GA60LD40</b> Microsemi Corporation IGBT 600V 121A 520W TO-264</p>	 <p><b>APT66M60L</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 70A TO-264</p>
 <p><b>APT70GR120JD60</b> Microsemi Corporation IGBT 1200V 112A 543W SOT227</p>	 <p><b>APT68GA60B</b> Microsemi Corporation IGBT 600V 121A 520W TO-247</p>	 <p><b>APT66M60B2</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 66A T-MAX</p>	 <p><b>APT6M100K</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 6A TO-220</p>

### APT68GA60B2D40 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">APT68GA60B2D40 Microsemi</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40 Datenblatt</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40-Datenblätter</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40 PDF</a>	<a href="#">Microsemi APT68GA60B2D40</a>
<a href="#">APT68GA60B2D40 Electronic</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40-Komponenten</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40-Verteiler</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40-Bild</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40-Teil</a>
<a href="#">APT68GA60B2D40 Preis</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40 Hersteller</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40 Bild</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40 Aktie</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40 Inventar</a>
<a href="#">APT68GA60B2D40 Neu</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40 Original</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40 garantiert</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40 RFQ</a>	<a href="#">APT68GA60B2D40 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited